

Invenția se referă la electronică, în particular la tehnologia de obținere a senzorilor, și poate fi utilizată pentru obținerea senzorilor pe baza straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal.

Procedeul de obținere a senzorilor, după prima variantă, include depunerea chimică a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un substrat în prezența razelor ultraviolete. Apoi se efectuează prelucrarea fototermică rapidă a materialelor obținute în vid, în aer sau în camera de gaze, de exemplu, cu oxigen.

Procedeul de obținere a senzorilor, după a doua variantă, include depunerea chimică a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un substrat în prezența razelor ultraviolete. Suplimentar are loc doparea materialelor obținute cu cel puțin o impuritate, donor sau acceptor, odată cu depunerea chimică. Apoi are loc prelucrarea fototermică rapidă a materialelor obținute în vid, în aer sau în camera de gaze, de exemplu, cu oxigen.

Procedeul de obținere a senzorilor, după a treia variantă, include depunerea chimică a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un substrat în prezența razelor ultraviolete. Apoi are loc suplimentar doparea materialelor obținute cu cel puțin o impuritate donor sau acceptor, se efectuează prelucrarea fototermică rapidă a materialelor obținute în vid, în aer sau în camera de gaze, de exemplu, cu oxigen.

Procedeul de obținere a senzorilor, după a patra variantă, include depunerea chimică a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un substrat în prezența razelor ultraviolete. Apoi are loc suplimentar prelucrarea fototermică rapidă a materialelor obținute în vid, în aer sau în camera de gaze, de exemplu, cu oxigen, și în același timp se efectuează doparea prin difuzie a lor cu cel puțin o impuritate, donor sau acceptor.

Procedeul de obținere a senzorilor, după a cincia variantă, include depunerea chimică a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un substrat în prezența razelor ultraviolete. Apoi se efectuează suplimentar doparea prin difuzie cu cel puțin o impuritate, donor sau acceptor, concentrația impurităților fiind maxim posibilă pentru materialul obținut, mai apoi se efectuează prelucrarea fototermică rapidă a materialelor obținute în vid, în aer sau în camera de gaze, de exemplu, cu oxigen, cu condiția micșorării temperaturii de la temperatura dopării, până la temperatura mediului înconjurător.

Revendicări: 5

Figuri: 4